

关键指标

频率：4.5~7GHz
增益：9dB
噪声系数：4.2dB
1dB 压缩点输出功率：18.5dBm
饱和输出功率：21dBm
电压/电流：+5V/45mA
芯片尺寸：1.1mm×0.8mm

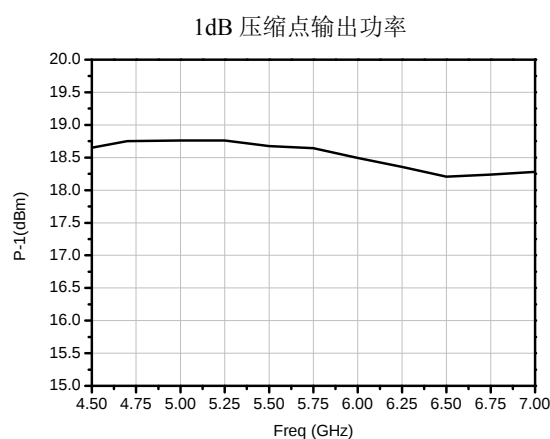
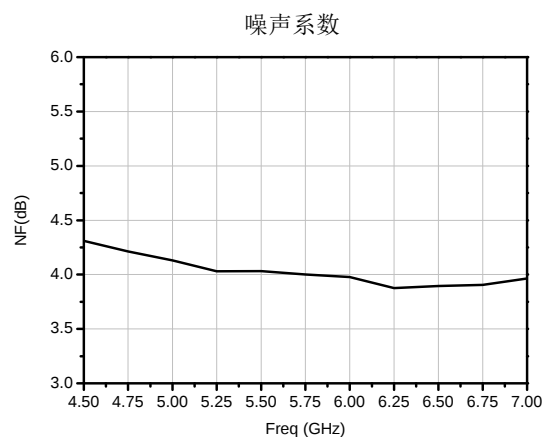
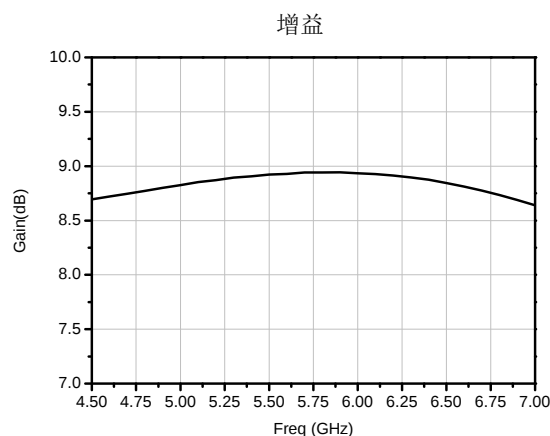
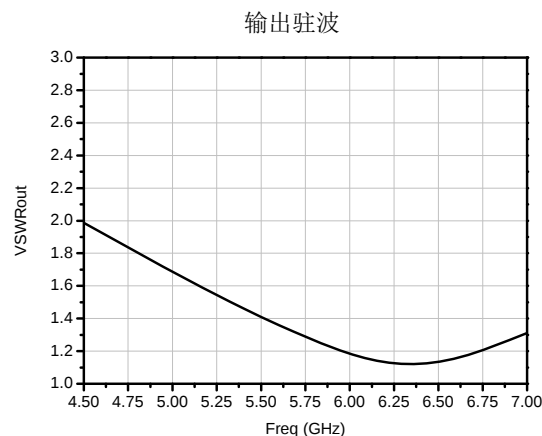
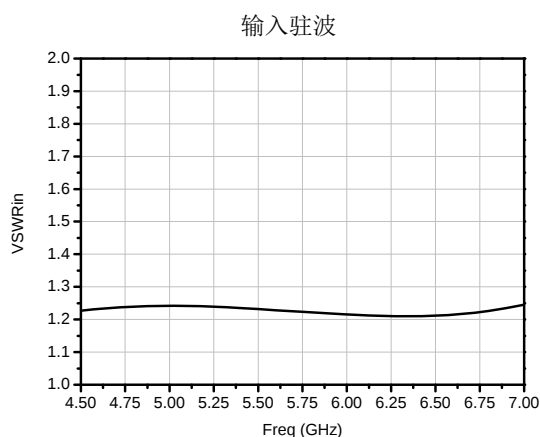
产品简介

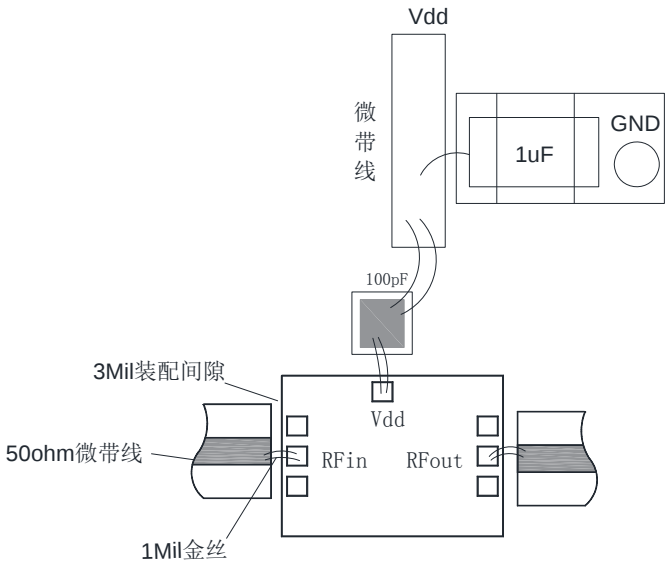
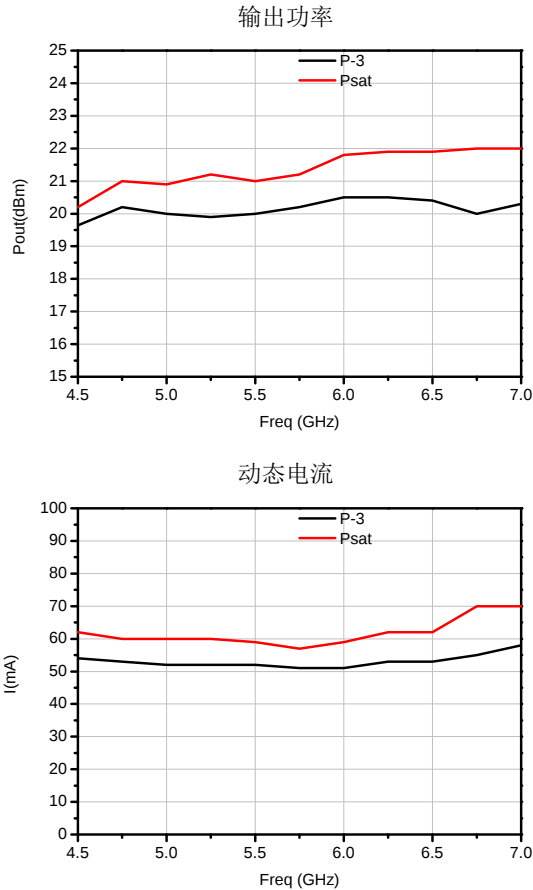
HG124F3 是一款 4.5~7GHz 的 C 波段驱动放大器芯片，增益为 9dB，噪声系数为 4.2dB，1dB 压缩点输出功率为 18.5dBm。该芯片射频输入输出均已集成隔直电容。

电性能（ $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ， $V_{dd}=+5\text{V}$ ）

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	4.5~7		
增益(dB)	—	9	—
增益平坦度(dB)	—	± 0.3	—
噪声系数(dB)	—	4.2	—
输入驻波	—	1.25	—
输出驻波	—	1.5	—
1dB 压缩点输出功率(dBm)	—	18.5	—
饱和输出功率(dBm)	—	21	—
静态电流 (mA)	—	45	—

典型测试曲线（ $V_{dd}=5\text{V}$ ）





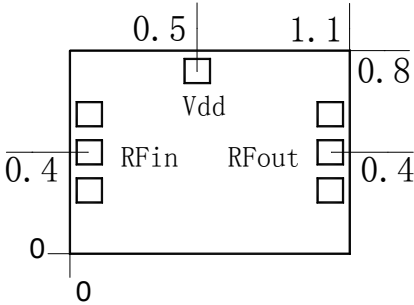
绝对额定最大值

工作电压	+6V
最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250~400μm；
5. 芯片射频输入输出端均有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。

外形和端口尺寸（mm）



推荐装配图